

(Продолжение. Начало — № 6/2001 г.)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сокращения параметров полупроводниковых приборов

В настоящее время практически каждому радиолюбителю и профессионалу приходится работать с различными справочными данными по подбору полупроводниковых приборов. При это возникают определенные трудности, когда необходимо разобраться с тем, что означает то или иное сокращение. Для того, чтобы восполнить этот пробел приводится таблица общепринятых сокращений при обозначении параметров полупроводниковых приборов.

Таблица 1

I_C	Collector Current	Ток коллектора
I_{CBO}	Collector Cutoff Current	Коллекторный ток отсечки
I_{CC}	Supply Current	Потребляемый ток
I_D	Monitor Dark Current (Laser) или Direct Current	Темновой ток лазерного диода или прямой ток
I_{DD}	Supply Current (drain for GaAs)	Потребляемый ток (ток стока для полевых транзисторов из арсенида галлия)
I_{DS}	Drain to Source Current	Ток сток — исток
I_{DSS}	Saturated Drain to Source Current	Ток насыщения сток — исток
I_{DQ}	Quiescent Drain Current	Статический ток стока
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current	Эмиттерный ток отсечки
I_{EE}	Supply Current (emitter for Silicon)	Потребляемый ток (ток эмиттера для кремниевых транзисторов)
I_F	Intermediate Frequency (prescalers)	Промежуточная частота (частота преобразования)
I_{FH}	High Level Input Current	Входной ток высокого уровня
I_{FL}	Low Level Input Current	Входной ток низкого уровня
I_G	Gate Current	Ток затвора
I_{GF}	Forward Gate Current	Прямой ток затвора
I_{GSO}	Gate to Source Leakage Current	Ток утечки затвор-исток
I_{MO}	Intermodulation Distorsion	Интермодуляционные искажения
I_{M2}	Second Order Intermodulation Distorsion	Интермодуляционные искажения 2-го порядка

Продолжение следует